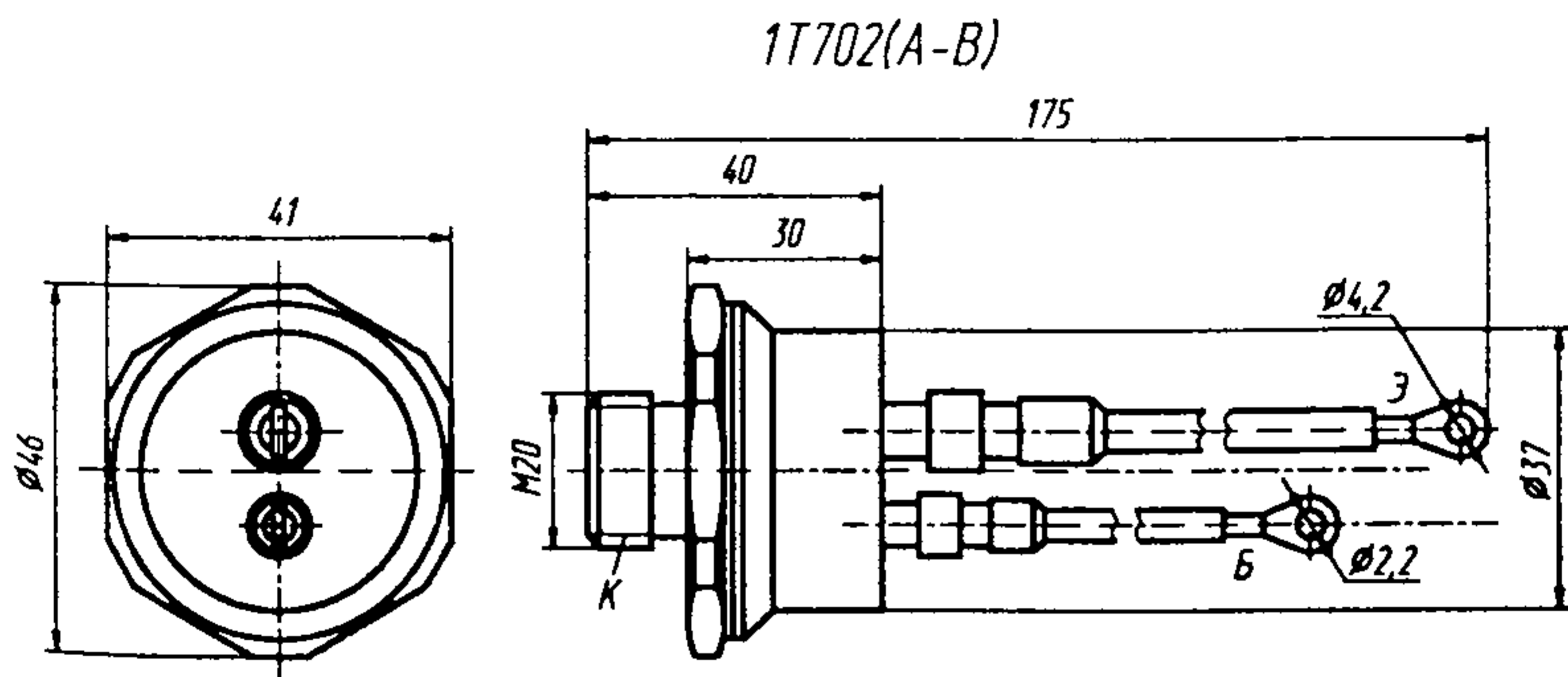


1Т702А, 1Т702Б, 1Т702В

Транзисторы германиевые сплавные структуры *p-n-p* универсальные низкочастотные мощные. Предназначены для применения в усилителях мощности низкой частоты, преобразователях напряжения, импульсных устройствах. Выпускаются в металлокерамическом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается на корпусе.

Масса транзистора не более 23 г.

Изготовитель — завод полупроводниковых приборов, г. Ташкент.



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 1,5$ В, $I_K = 30$ А:

1Т702А, 1Т702Б	15...100
1Т702В, не менее	20

Модуль коэффициента передачи тока на высокой частоте при $f = 10$ кГц, $U_{КБ} = 1,5$ В, $I_K = 4$ А, не менее

12

Граничное напряжение при $I_K = 2,5$ А, не менее:

$T = +25$ °С:

1Т702А, 1Т702Б	60 В
1Т702В	40 В

$T_K = +70$ °С:

1Т702А, 1Т702Б	45 В
1Т702В	30 В

$T = -60$ °С:

1Т702А, 1Т702Б	45 В
1Т702В	35 В

Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_K = 30$ А, $I_B = 3$ А, не более:	
1Т702А, 1Т702В	0,6 В
1Т702Б	1,2 В
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 60$ В, не более:	
$T = +25$ °С	12 мА
$T_K = +70$ °С	30 мА
$T = -60$ °С	10 мА
Обратный ток эмиттера при $U_{БЭ} = 4$ В, не более	
	2 мА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $U_{БЭ} = 3$ В:	
1Т702А, 1Т702Б	60 В
1Т702В	40 В
Постоянное напряжение коллектор—база	60 В
Постоянное напряжение база—эмиттер	4 В
Постоянный ток коллектора	30 А
Постоянный ток базы	5 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора:	
с теплоотводом:	
$T_K = +30$ °С	150 Вт
$T_K = +50$ °С	80 Вт
$T_K = +65$ °С	30 Вт
без теплоотвода, $T = +25$ °С	5 Вт
Тепловое сопротивление переход—корпус	0,3 °С/Вт
Тепловое сопротивление переход—окружающая среда	10 °С/Вт
Температура $p-n$ перехода	+75 °С
Температура окружающей среды	-60... $T_K = +70$ °С

Не допускается отсоединение цепи базы транзистора при наличии напряжения между коллектором и эмиттером.